













































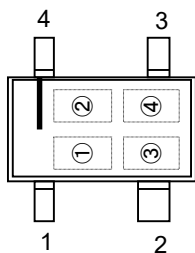




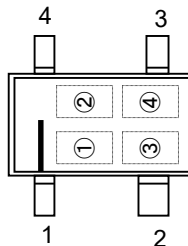


## ■マーキング

### ●SSOT-24



SSOT24(方向上バー付きタイプ)



SSOT24(方向下バー付きタイプ)

①-1 製品シリーズを表す。検出電圧範囲、出力形態を表す。

シンボル	出力形態	検出電圧[V]	解除遅延時間/検出論理	品名表記例
5	CMOS	奇数	50ms/Low	XC6127C15A**-G ~ XC6127C55A**-G
6			100ms/Low	XC6127C15B**-G ~ XC6127C55B**-G
7			200ms/Low	XC6127C15C**-G ~ XC6127C55C**-G
8			400ms/Low	XC6127C15D**-G ~ XC6127C55D**-G
9			800ms/Low	XC6127C15E**-G ~ XC6127C55E**-G
A			50ms/High	XC6127C15F**-G ~ XC6127C55F**-G
B			100ms/High	XC6127C15G**-G ~ XC6127C55G**-G
C			200ms/High	XC6127C15H**-G ~ XC6127C55H**-G
D			400ms/High	XC6127C15J**-G ~ XC6127C55J**-G
E			800ms/High	XC6127C15K**-G ~ XC6127C55K**-G
F		偶数	50ms/Low	XC6127C16A**-G ~ XC6127C54A**-G
H			100ms/Low	XC6127C16B**-G ~ XC6127C54B**-G
K			200ms/Low	XC6127C16C**-G ~ XC6127C54C**-G
N			400ms/Low	XC6127C16D**-G ~ XC6127C54D**-G
P			800ms/Low	XC6127C16E**-G ~ XC6127C54E**-G
R			50ms/High	XC6127C16F**-G ~ XC6127C54F**-G
S			100ms/High	XC6127C16G**-G ~ XC6127C54G**-G
T			200ms/High	XC6127C16H**-G ~ XC6127C54H**-G
U			400ms/High	XC6127C16J**-G ~ XC6127C54J**-G
V			800ms /Low	XC6127C16K**-G ~ XC6127C54K**-G

※CMOS 品は、上方向バー仕様とする。



## ■マーキング

①-2 製品シリーズを表す。検出電圧範囲、出力形態を表す。

シンボル	出力形態	検出電圧[V]	解除遅延時間/検出論理	品名表記例
0	Nch	奇数	50ms/Low	XC6127N15A**-G ~ XC6127N55A**-G
1			100ms/Low	XC6127N15B**-G ~ XC6127N55B**-G
2			200ms/Low	XC6127N15C**-G ~ XC6127N55C**-G
3			400ms/Low	XC6127N15D**-G ~ XC6127N55D**-G
4			800ms/Low	XC6127N15E**-G ~ XC6127N55E**-G
5			50ms/High	XC6127N15F**-G ~ XC6127N55F**-G
6			100ms/High	XC6127N15G**-G ~ XC6127N55G**-G
7			200ms/High	XC6127N15H**-G ~ XC6127N55H**-G
8			400ms/High	XC6127N15J**-G ~ XC6127N55J**-G
9			800ms/High	XC6127N15K**-G ~ XC6127N55K**-G
A		偶数	50ms/Low	XC6127N16A**-G ~ XC6127N54A**-G
B			100ms/Low	XC6127N16B**-G ~ XC6127N54B**-G
C			200ms/Low	XC6127N16C**-G ~ XC6127N54C**-G
D			400ms/Low	XC6127N16D**-G ~ XC6127N54D**-G
E			800ms/Low	XC6127N16E**-G ~ XC6127N54E**-G
F			50ms/High	XC6127N16F**-G ~ XC6127N54F**-G
H			100ms/High	XC6127N16G**-G ~ XC6127N54G**-G
K			200ms/High	XC6127N16H**-G ~ XC6127N54H**-G
L			400ms/High	XC6127N16J**-G ~ XC6127N54J**-G
M			800ms/High	XC6127N16K**-G ~ XC6127N54K**-G

※Nch 品は、下方向バー仕様とする。

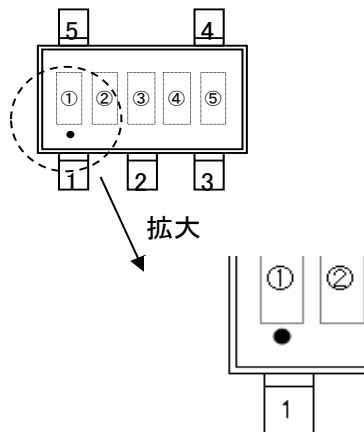
② 検出電圧を表す

シンボル	検出電圧(V)		シンボル	検出電圧(V)		シンボル	検出電圧(V)	
A	1.5	1.6	K	2.9	3.0	T	4.3	4.4
B	1.7	1.8	L	3.1	3.2	U	4.5	4.6
C	1.9	2.0	M	3.3	3.4	V	4.7	4.8
D	2.1	2.2	N	3.5	3.6	X	4.9	5.0
E	2.3	2.4	P	3.7	3.8	Y	5.1	5.2
F	2.5	2.6	R	3.9	4.0	Z	5.3	5.4
H	2.7	2.8	S	4.1	4.2	0	5.5	-

③④ 製造ロットを表す。01~09, 0A~0Z, 11~9Z, A1~A9, AA~AZ, B1~ZZ を繰り返す。  
(但し、G, I, J, O, Q, W は除く。反転文字は使用しない。)

## ■マーキング

●SOT-25



① 製品シリーズと出力形態を表す

シンボル	出力形態	品名表記例
5	CMOS	XC6127C****-G
6	Nch	XC6127N****-G

② 検出電圧を表す

シンボル	検出電圧(V)		シンボル	検出電圧(V)		シンボル	検出電圧(V)	
A	1.5	1.6	K	2.9	3.0	T	4.3	4.4
B	1.7	1.8	L	3.1	3.2	U	4.5	4.6
C	1.9	2.0	M	3.3	3.4	V	4.7	4.8
D	2.1	2.2	N	3.5	3.6	X	4.9	5.0
E	2.3	2.4	P	3.7	3.8	Y	5.1	5.2
F	2.5	2.6	R	3.9	4.0	Z	5.3	5.4
H	2.7	2.8	S	4.1	4.2	0	5.5	-

③ 検出電圧範囲と解除遅延時間/検出論理を表す。

シンボル	検出電圧[V]	解除遅延時間/検出論理	品名表記例
A	奇数	50ms/Low	XC6127*15A**-G ~ XC6127*55A**-G
B		100ms/Low	XC6127*15B**-G ~ XC6127*55B**-G
C		200ms/Low	XC6127*15C**-G ~ XC6127*55C**-G
D		400ms/Low	XC6127*15D**-G ~ XC6127*55D**-G
E		800ms/Low	XC6127*15E**-G ~ XC6127*55E**-G
F		50ms/High	XC6127*15F**-G ~ XC6127*55F**-G
H		100ms/High	XC6127*15G**-G ~ XC6127*55G**-G
K		200ms/High	XC6127*15H**-G ~ XC6127*55H**-G
L		400ms/High	XC6127*15J**-G ~ XC6127*55J**-G
M		800ms/High	XC6127*15K**-G ~ XC6127*55K**-G
N	偶数	50ms/Low	XC6127*16A**-G ~ XC6127*54A**-G
P		100ms/Low	XC6127*16B**-G ~ XC6127*54B**-G
R		200ms/Low	XC6127*16C**-G ~ XC6127*54C**-G
S		400ms/Low	XC6127*16D**-G ~ XC6127*54D**-G
T		800ms/Low	XC6127*16E**-G ~ XC6127*54E**-G
U		50ms/High	XC6127*16F**-G ~ XC6127*54F**-G
V		100ms/High	XC6127*16G**-G ~ XC6127*54G**-G
X		200ms/High	XC6127*16H**-G ~ XC6127*54H**-G
Y		400ms/High	XC6127*16J**-G ~ XC6127*54J**-G
Z		800ms/High	XC6127*16K**-G ~ XC6127*54K**-G

④⑤ 製造ロットを表す。01~09, 0A~0Z, 11~9Z, A1~A9, AA~AZ, B1~ZZ を繰り返す。  
(但し、G, I, J, O, Q, W は除く。反転文字は使用しない。)

1. 本データシートに記載された内容(製品仕様、特性、データ等)は、改善のために予告なしに変更することがあります。製品のご使用にあたっては、その最新情報を当社または当社代理店へお問い合わせ下さい。
2. 本データシートに記載された内容は、製品の代表的動作及び特性を説明するものでありそれらの使用に関連して発生した第三者の知的財産権の侵害などに関し当社は一切その責任を負いません。又その使用に際して当社及び第三者の知的財産権の実施許諾を行うものではありません。
3. 本データシートに記載された製品或いは内容の情報を海外へ持ち出される際には、「外国為替及び外国貿易法」その他適用がある輸出関連法令を遵守し、必要な手続きを行って下さい。
4. 本製品は、1)原子力制御機器、2)航空宇宙機器、3)医療機器、4)車両・その他輸送機器、5)各種安全装置及び燃焼制御装置等々のように、その機器が生命、身体、財産等へ重大な損害を及ぼす可能性があるような非常に高い信頼性を要求される用途に使用されることを意図しておりません。これらの用途への使用は当社の事前の書面による承諾なしに使用しないで下さい。
5. 当社は製品の品質及び信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生します。故障のために生じる人身事故、財産への損害を防ぐためにも設計上のフェールセーフ、冗長設計及び延焼対策にご留意をお願いします。
6. 本データシートに記載された製品には耐放射線設計はなされていません。
7. 保証値を超えた使用、誤った使用、不適切な使用等に起因する損害については、当社では責任を負いかねますので、ご了承下さい。
8. 本データシートに記載された内容を当社の事前の書面による承諾なしに転載、複製することは、固くお断りします。

トレックス・セミコンダクター株式会社